

ブリッジダイオード
Bridge Diode

大容量 シングルインライン型 Large Io Single In-line Package

D50XB80

800V 50A

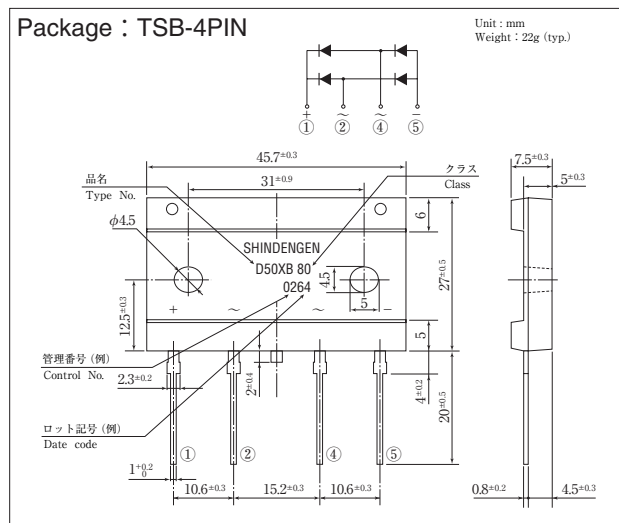
特長

- 薄型SIPパッケージ
- 高耐圧・高 I_{FSM}
- 大電流容量
- UL E142422
- 高放熱伝導性

Feature

- Thin-SIP
- High Voltage・Large I_{FSM}
- Large I_o
- UL E142422
- High Thermal Radiation

■外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS



(製品上の表示については、捺印仕様をご確認ください)

■定格表 RATINGS

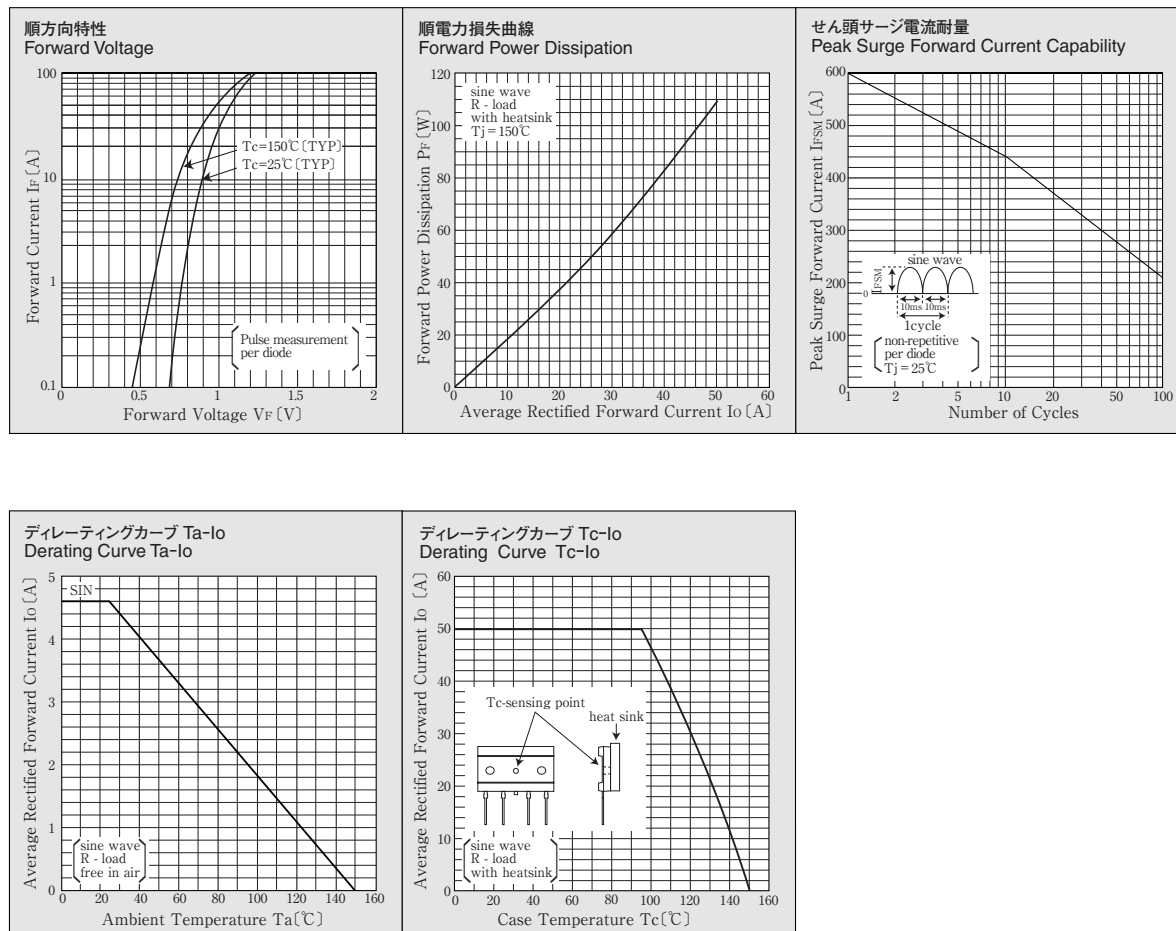
●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合は $T_c = 25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	D50XB80	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	T_{stg}			-40~150	$^\circ\text{C}$
接合部温度 Operation Junction Temperature	T_j			150	$^\circ\text{C}$
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V_{RM}			800	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I_o	50Hz 正弦波, 抵抗負荷 50Hz sine wave, Resistance load	フィン付き With heatsink $T_c = 95^\circ\text{C}$	50.0	A
			フィンなし Without heatsink $T_a = 26^\circ\text{C}$	4.6	
せん頭サーージ順電流 Peak Surge Forward Current	I_{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, 一素子当たりの規格値, $T_j = 25^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1cycle peak value, $T_j = 25^\circ\text{C}$		600	A
電流二乗時間積 Current Squared Time	I^2t	$1\text{ms} \leq t < 10\text{ms}$		1800	A^2s
絶縁耐圧 Dielectric Strength	V_{dis}	一括端子・ケース間, AC 1分間印加 モールド部上面 (端子と平行面) は除く Terminals to Case, AC 1 minute Except top (opposite side of the terminal side) of the mold case.		2.0	kV
締め付けトルク Mounting Torque	TOR	(推奨値: 1.2 N・m) (Recommended torque : 1.2 N・m)		1.5	N・m

●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合は $T_c = 25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

順電圧 Forward Voltage	V_F	$I_F = 25\text{A}$, パルス測定, 一素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 1.05	V
逆電流 Reverse Current	I_R	$V_R = 800\text{V}$, パルス測定, 一素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 10	μA
熱抵抗 Thermal Resistance	θ_{jc}	接合部・ケース間 Junction to Case	MAX 0.5	$^\circ\text{C}/\text{W}$
	θ_{ja}	接合部・周囲間 Junction to Ambient	MAX 16	

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



- ・ Sine waveは50Hzで測定しています。
- ・ 50Hz sine wave is used for measurements.
- ・ 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っています。Typicalは統計的な実力を表しています。
- ・ Semiconductor products generally have characteristic variation. Typical is a statistical average of the device's ability.